

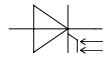
Technische Information / Technical Information

eupec

Lichtgezündeter Netz Thyristor
mit integriertem. ÜberspannungsschutzPhase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection

T 2563 N 75...80 TOH

N



Features:

**Lichtgezündeter Netz Thyristor
mit integriertem. Überspannungsschutz**

Volle Sperrfähigkeit bei 120° mit 50 Hz

Hoher Stoßstrom mit hohem di/dt
und niedriger Wärmewiderstand durch
NTV-Verbindung zwischen Silizium
und Mo-Trägerscheibe.

Elektroaktive Passivierung durch a - C:H

**Phase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection**

Full blocking capability at 120°C with 50 Hz

High surge current with high di/dt and low
thermal resistance by using low temperature-
connection NTV between silicon wafer
and molybdenum

Electroactive passivation by a - C:H

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak reverse voltage	f = 50 Hz	V_{RRM}	$T_{vj \min} = -40^{\circ}\text{C}$ 7500 8000	$T_{vj \min} = 0^{\circ}\text{C}$ 7700 8200	V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS forward current		I_{TRMSM}		5600	A
Dauergrenzstrom mean forward current	$T_C = 85^{\circ}\text{C}, f = 50\text{Hz}$ $T_C = 60^{\circ}\text{C}, f = 50\text{Hz}$	I_{TAVM}		2560 3570	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10\text{ms}$	I_{TSM}		63 56	kA kA
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj \max}, t_p = 10\text{ms}$	I^2t		$19,8 \cdot 10^6$ $15,7 \cdot 10^6$	A^2s A^2s
Kritische Stromsteilheit, periodisch critical rate of rise of on-state current, periodical	DIN IEC 747-6 $V_D \leq V_{BO}, f = 50\text{Hz},$ $P_L = 40\text{mW}, t_{rise} = 0,5\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$		300	A/ μs
Kritische Stromsteilheit, nicht-periodisch critical rate of rise of on-state current, non-periodical	DIN IEC 747-6 $V_D \leq V_{BO}, P_L = 40\text{mW}, t_{rise} = 0,5\mu\text{s}$	$(di/dt)_{cr}$		1000	A/ μs
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of forward voltage	$T_{vj} = T_{vj \max}, V_{DM} = 5\text{kV}$	$(dv/dt)_{cr}$		2000	V/ μs

Technische Information / Technical Information

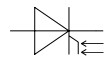
eupec

Lichtgezündeter Netz Thyristor
mit integriertem. Überspannungsschutz

T 2563 N 75...80 TOH

Phase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection

N



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Schutzzündspannung (statisch) protective break over voltage	$T_{vj} = 0^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	V_{BO}	min. 7500	V
Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, i_T = 6\text{kA}$	v_T	typ. 2,75 max. 2,95	V
Schleusenspannung / threshold voltage Ersatzwiderstand / slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	V_{TO} r_T	typ. 1,23 max. 1,28 0,253 0,278	V mΩ
Durchlaßrechenkennlinie on-state characteristics for calculations $V_T = A + B \cdot i_T + C \cdot \ln(i_T + 1) + D \cdot \sqrt{i_T}$ 500 A $\leq i_T \leq$ 6000 A	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	A B C D	typ. max. -0,00607 -0,00503 0,000181 0,000187 0,162 0,160 0,00342 0,00570	
erforderliche Zündlichtleistung required gate trigger light power	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 100\text{V}$	P_{LM}	min. 40	mW
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_H	100	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 100\text{V},$ $P_{LM} = 40\text{mW}, t_{an} = 0,5\mu\text{s}$	I_L	1	A
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $v_D = v_R = 7500\text{V}$	i_D, i_R	900	mA
Zündverzug gate controlled delay time	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_D = 1000\text{V},$ $P_{LM} = 40\text{mW}, t_{an} = 0,5\mu\text{s}$	t_{gd}	typ. 5	μs
Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, I_{TM} = I_{TAVM}$ $v_{RM} = 100\text{V}, v_{DM} = 0,67 \cdot v_{DRM}$ $dv_D/dt = 20\text{V}/\mu\text{s}, -di_T/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ 4. Kennbuchstabe / 4 th letter O	t_q	typ. 550	μs
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $I_{TM} = 2,5\text{kA}, di/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ $v_R = 0,5 \cdot v_{RRM}, v_{RM} = 0,8 \cdot v_{RRM}$	Q_r	22	mAs
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $I_{TM} = 2,5\text{kA}, di/dt = 10\text{A}/\mu\text{s}$ $v_R = 0,5 \cdot v_{RRM}, v_{RM} = 0,8 \cdot v_{RRM}$	I_{RM}	400	A

Technische Information / Technical Information

eupec

Lichtgezündeter Netz Thyristor
mit integriertem. Überspannungsschutz

T 2563 N 75...80 TOH

Phase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection

N



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	beidseitig / two-sided, $\Theta = 180^\circ \sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode DC Kathode / cathode DC	R_{thJC}	0,0046 0,0043 0,0075 0,01	$^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCK}	0,001 0,002	$^\circ\text{C/W}$ $^\circ\text{C/W}$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj \max}$	+120	$^\circ\text{C}$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c \text{ op}}$	-40...+120	$^\circ\text{C}$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40...+150	$^\circ\text{C}$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 4	
Si-Element mit Druckkontakt, Lichtzündung Si-pellet with pressure contact, light triggered	Silizium Tablette silicon wafer		119LTN80	
Anpreßkraft clamp force		F	90...130	kN
Gewicht weight		G	typ. 4000	g
Kriechstrecke creepage distance			49	mm
Feuchteklasse humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s^2

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen technischen Erläuterungen.
This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.

Technische Information / Technical Information

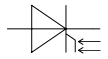


Lichtgezündeter Netz Thyristor
mit integriertem. Überspannungsschutz

T 2563 N 75...80 TOH

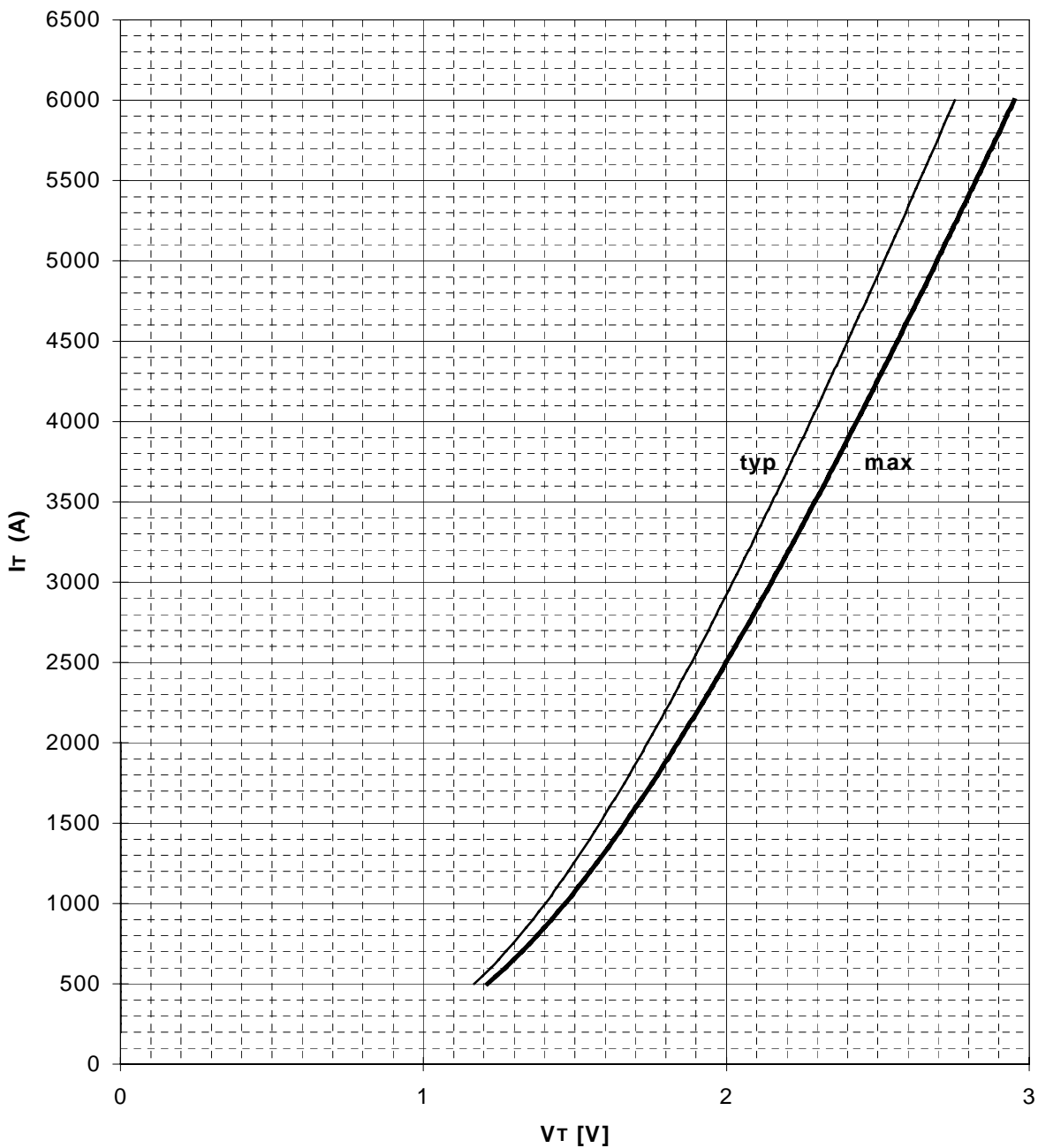
Phase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection

N



Durchlaßkennlinien $i_T = f(v_T)$ Limiting and typical on-state characteristic

$T_{vj} = 120^\circ\text{C}$



Technische Information / Technical Information

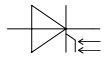


Lichtgezündeter Netz Thyristor
mit integriertem Überspannungsschutz

T 2563 N 75...80 TOH

Phase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection

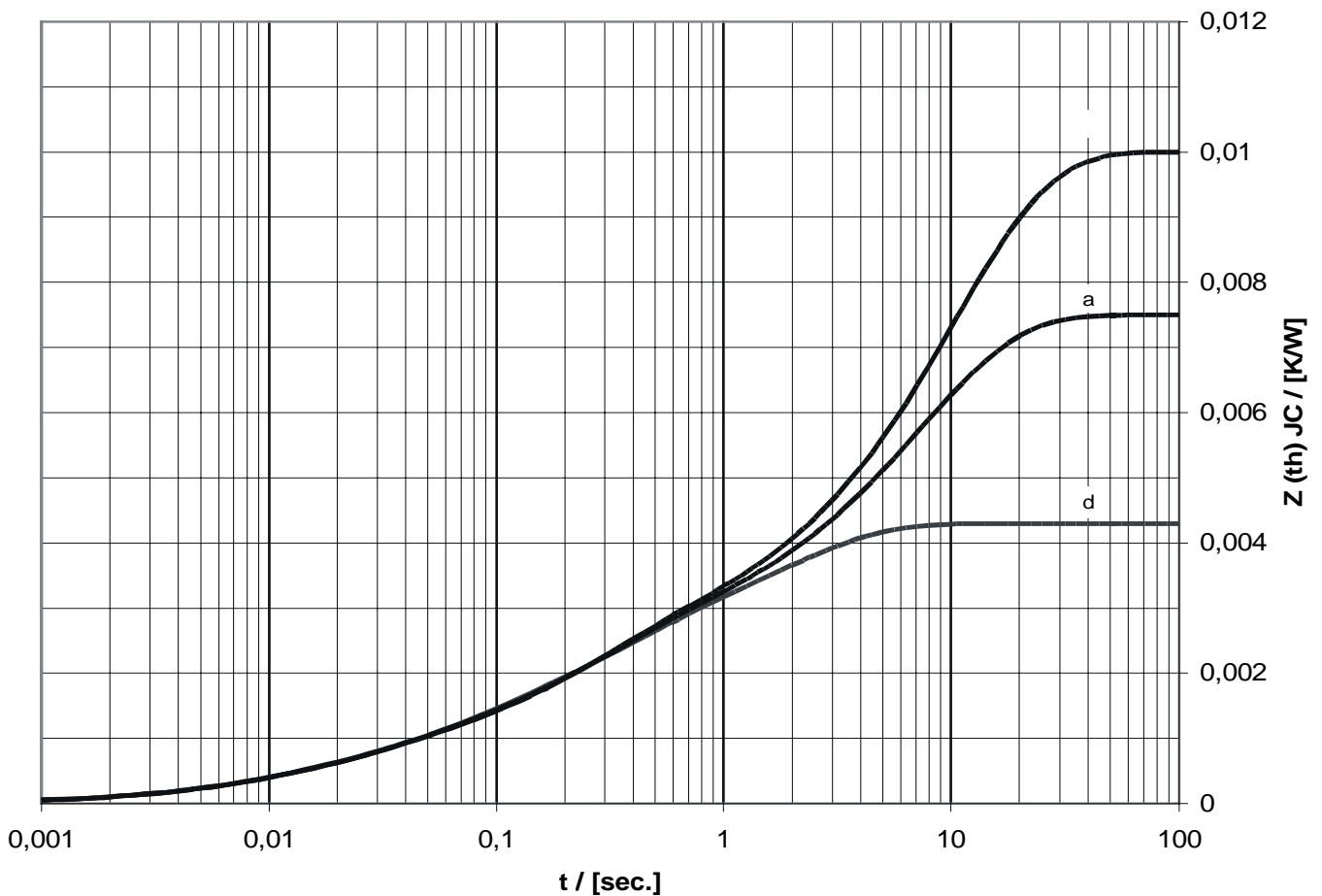
N



Transienter innerer Wärmewiderstand Transient thermal impedance $Z_{(th)JC} = f(t)$

$$Z_{th\,JC}(t) = R_{th\,n} \cdot (1 - e^{-t/\tau_n})$$

	doppelseitige Kühlung		anodenseitige Kühlung		kathodenseitige Kühlung	
	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]	r [K/W]	[s]
1	0,00183	1,9	0,00465	7,5	0,00715	10,2
2	0,00132	0,3	0,00052	0,85	0,00052	0,85
3	0,00075	0,065	0,00157	0,225	0,00157	0,225
4	0,00038	0,011	0,00054	0,029	0,00054	0,029
5	0,00002	0,003	0,00022	0,0075	0,00022	0,0075
	0,0043	-	0,0075	-	0,01	-



Technische Information / Technical Information

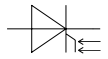


Lichtgezündeter Netz Thyristor
mit integriertem. Überspannungsschutz

T 2563 N 75...80 TOH

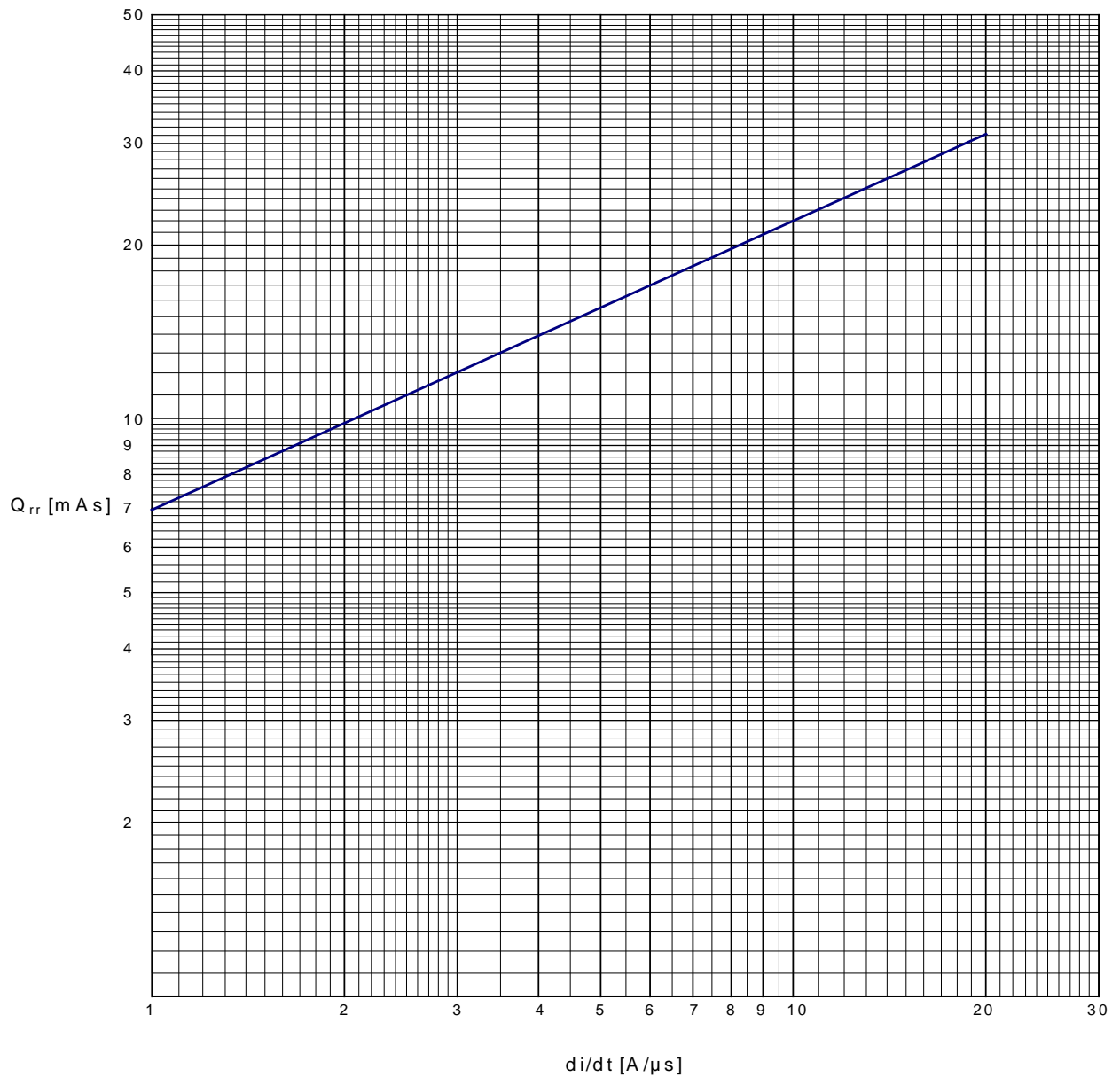
Phase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection

N



Sperrverzögerungsladung $Q_r = f(-di/dt)$ recovered charge

Nebenbedingungen: $T_{vj} = 120^\circ\text{C}$, $I_{TM} = 2500\text{A}$, $V_R = 0,5 \cdot V_{RRM}$, $V_{RM} = 0,8 \cdot V_{RRM}$



Technische Information / Technical Information

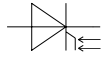
eupec

Lichtgezündeter Netz Thyristor
mit integriertem. Überspannungsschutz

T 2563 N 75...80 TOH

Phase Control Thyristor, light triggered
with integrated overvoltage protection

N



Rückstromspitze / reverse recovery current

(typische Abhängigkeit / typical dependence)

$$I_{RM} = f(-di/dt)$$

$$T_{vj} = 120^{\circ}\text{C}, I_{TM} = 2500\text{A}, v_R = 0,5 \cdot V_{RRM}, v_{RM} = 0,8 \cdot V_{RRM}$$

